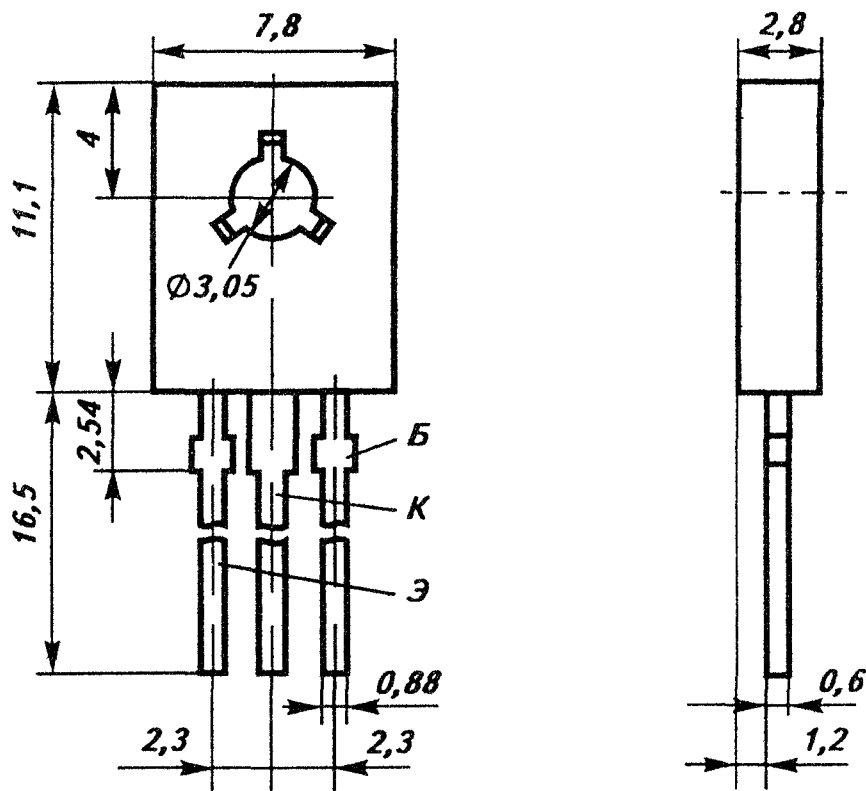


□ КТ646А, КТ646Б



КТ646(А,Б)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты, импульсных и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 1 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб}=5$ В, $I_{э} = 0,2$ А	
КТ646А	40 2000
КТ646Б не менее	150
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_{э} = 30$ мА	
не менее	250 МГц

51

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{кб} = 5$ В, $I_{э} = 50$ мА, $f = 5$ МГц, не более	120 пс
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, не более	
КТ646А при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{б} = 50$ мА	0,85 В
КТ646Б при $I_{к} = 0,2$ А, $I_{б} = 20$ мА	0,25 В
Напряжение насыщения база-эмиттер, не более	
КТ646А при $I_{к} = 0,5$ А, $I_{б} = 50$ мА	1,2 В
КТ646Б при $I_{к} = 0,2$ А, $I_{б} = 20$ мА	1,2 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более	10 пф
Емкость эмиттерного перехода при $U_{кб} = 0$, не более	80 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$, не более	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В, не более	10 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
КТ646А	60 В
КТ646Б	40 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм	
КТ646А	50 В
КТ646Б	40 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	4 В
Импульсное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	0,5 А
Импульсный ток коллектора	0,7 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	1 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора	1,2 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Температура окружающей среды	-45 +85°C